

**CMPTA29**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH VOLTAGE**  
**NPN SILICON**  
**DARLINGTON TRANSISTOR**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPTA29 is an NPN silicon darlington transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for applications requiring extremely high voltage and high gain.

**MARKING CODE: C29**



**SOT-23 CASE**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	100	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	12	V
Continuous Collector Current	$I_C$	500	mA
Power Dissipation	$P_D$	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\theta_{JA}$	357	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ ) unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$I_{CES}$	$V_{CE}=80\text{V}$		500	nA
$I_{CBO}$	$V_{CB}=80\text{V}$		100	nA
$I_{EBO}$	$V_{BE}=10\text{V}$		100	nA
$BV_{CES}$	$I_C=100\mu\text{A}$	100		V
$BV_{CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	100		V
$BV_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$	12		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=10\mu\text{A}$		1.2	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=100\mu\text{A}$		1.5	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$		2.0	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}$	10,000		
$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$	10,000		
$f_T$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	125		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0	pF

**CMPTA29**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH VOLTAGE**  
**NPN SILICON**  
**DARLINGTON TRANSISTOR**



**SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



**LEAD CODE:**

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

**MARKING CODE: C29**

<b>DIMENSIONS</b>				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R4 (3-February 2010)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9